# 仿真需求：

每个仿真点，都需要仿真10 20~100GeV的能量 500次

提取出三个关键值作图，**横坐标是仿真要素**，纵坐标分**别是 10G 100G能量点的分辨率**，

画图

1**沉积能量**VS 入射能量关系图，不同情况放一张图中 标明 **Slope** 和 **INL**

2**分辨率**VS 入射能量（不需要开根号），不同情况放入同一张图，标明**y=1.6**的位置和**X** 100Ge位置 不同情况都用 图中表格说明a b

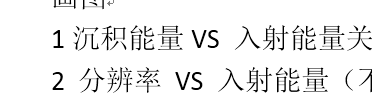
Step2

1. **仿真W厚度**，无其他材料

沉积能量随深度分布&沉积积分 同一张图 并标明积分后95%位置（虚线标明）

1. 确定总厚度之后，选择（90mm） 作为总厚度，**对Si层数**进行仿真

仿真加入2mm FR4材料，紧贴Si ，对层数60-55-…-30 进行仿真 结果画



1. 硅PIN单元尺寸VS最大沉积能量
2. 加误差

## 针对量能器

## 总厚度 默认90mm

50-----120

### W板厚度（间隔） 默认1.5mm

1 1.5 2 2.5 3

### 敏感面积 默认 1cm2

### 硅厚度 默认400um

100 200 300 400 --- 700

### 死区 默认0

1% 2% 4% 8% 5%

### W板间距

400 800 1500 2000 3000 4000 5000

## 针对实际情况

## 针对原理样机